삼성전자, 반도체 기술개발 "공격적"

하이닉스도 미세공정 개발 박차 … 타이완·일본기업 추격 따돌리기

삼성전자와 하이닉스가 공격적인 반도체 기술개발을 통해 타이완·일본기업과의 격차를 벌리고 있다.

삼성전자는 7월 말부터 40나노급 미세공정을 적용한 2기가비트(Gb) DDR3 D램 제품을 양산하는데 이어 30나노급 공정 개발도 진행하고 있다.

또 낸드플래시 메모리 시장의 구원병으로 등장한 SSD(Solid State Disc) 시장을 개척하기 위해 2009년까지 30나노급 SSD 개발을 마치고 2010년 초부터 본격 공급할 계획이다.

삼성전자는 2009년 2/4분기 반도체 부문이 2400억원(연결기준)의 영업이익을 기록하며 글로벌 메모리 반도체기업 가운데 유일하게 흑자를 달성했다.

최근 2년간 세계 반도체 기업들이 출혈경쟁을 불사하는 가운데 미세공정 개발과 원가절감에 집중해 기술 선점에 성공한 결과로 해석된다.

하이닉스도 2009년 4/4분기부터 40나노급 DDR3 D램 양산에 들어간다.

하이닉스는 2/4분기 2110억원의 영업적자를 냈지만, 1/4분기에는 5150억원 적자에 비해 적자폭이 크게 줄었고, 영업손실율도 13%로 3위인 Micron의 영업손실률보다 양호했다.

김종갑 하이닉스 사장은 7월24일 실적을 발표한 후 "해외기업들은 50나노급에도 진입을 못하고 있다"며 "2010년에는 D램 시장에서 확고한 리더십을 갖출 수 있을 것으로 보고 있다"고 말했다.

또 "2004-06년에는 설비투자가 경쟁의 요체였지만 이제는 기술 개발력"이라며 치열한 가격 경쟁 때문에 7분기 연속 적자를 냈지만 기술력에 앞서 있어서 전망은 밝다고 덧붙였다.

차세대 D램으로 불리는 DDR3 D램은 프리미엄이 DDR2보다 높지만 글로벌 시장에서 이 제품을 만들 수 있는 곳은 삼성전자와 하이닉스, 일본 Elpida Memory정도로 꼽히고 있다.

메리츠증권 이선태 애널리스트는 "후발기업들의 감산이 반도체 경기회복의 주요 원인"이라며 "상대적으로 우수한 기술력을 갖추고 생산을 확대하는 국내기업의 시장점유율이 더욱 높아질 것"이라고 전망했다. <저작권자 연합뉴스 - 무단전재·재배포 금지>

<화학저널 2009/07/27>

Copyright ⓒ 2003 by CMRI 화학경제연구원